

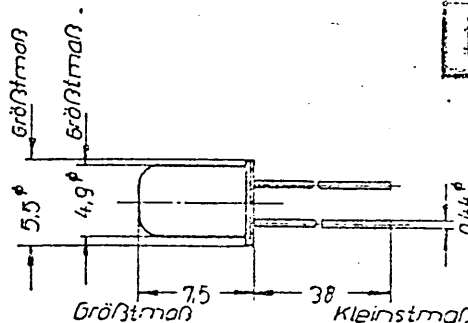
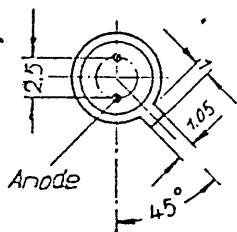
Silizium-Gleichrichter

125 mA

Nortron 0100 ... 0114

1963

NFN Nicht für Neutronenstr.



M 1:1

M 2:1

* Spitzensperrspannung V	* Nennsperrspannung V	* Sperrstrom bei $U_{sp\ max}$ μA	Typ	
75	50	0,1	0100	
150	100		0101	
300	200		0102	
75	50	1,0	0110	
150	100		0111	
300	200		0112	
500	400	10,0	0114	

1. Eigenschaften:

Verlustleistung:

250 mW bei $\leq +50^\circ C$ t_{umg}

Wärmewiderstand:

$\leq 0,4^\circ C/mW$

Größe Kristalltemperatur:

$+150^\circ C$

Lagertemp.-Bereich:

$-55^\circ C$ bis $+150^\circ C$

* Größte Durchlaß-Spannung:

$\leq 1V$ bei $25^\circ C$ t_{umg} und
100 mA Durchlaßstrom

Größter period. Spitzenstrom:

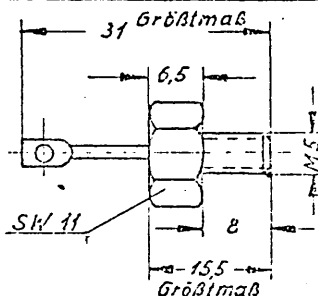
500 mA

Größter Stromstoß:

1A (Einschaltspitze)

Diode Silizium

**Nortron
0241....**



Serie 024. : Anode am Gehäuse
Serie 024. R : Kathode am Gehäuse

NAN Nicht für
Neukonstr.

Spitzensperrspannung U_{RSP} (V)	Stoßspannung U_{Rstoss} (V)	Sperrstrom $\leq 5 \mu A$ bei U_R (V)	Typ
100	150	75	0241
200	250	150	0242
300	400	200	0243
500	600	400	0245
800	800	700	0248

Spitzensperrspannung U_{RSP} (V)	Stoßspannung U_{Rstoss} (V)	Sperrstrom $\leq 5 \mu A$ bei U_R (V)	Typ
100	150	75	0241 R
200	250	150	0242 R
300	400	200	0243 R
500	600	400	0245 R
800	800	700	0248 R

1. Eigenschaften
- 1.1. Mechanische Ausführung:
 - 1.1.1. Gehäuseart: JEDEC /DIN
 - 1.1.2. Gehäusewerkstoff:
 - 1.1.3. Gehäuseoberfläche:
 - 1.1.4. Anschlußdrähte lötlbar verzinkt/vergoldet

- 1.2. Grenzwerte:
 - 1.2.1. Sperrspannung:
 - 1.2.2. Spitzen-Sperrspannung:
 - 1.2.3. Stoßspannung:
 - 1.2.4. Dauergrenzstrom:
 - 1.2.5. Durchlaß-Spitzestrom:
 - 1.2.6. Durchlaß-Stromstoß:
 - 1.2.7. Verlustleistung:
 - 1.2.8. Temperaturbereich (Lagerung):
 - 1.2.9. Sperrschichttemperatur:
 - 1.2.10. Löttemperatur:

Formelzeichen	Wert	Meßbedingung
U_R	— V	$I_R = — A, U_G = — ^\circ C$
U_{RSP}	siehe Tabelle V	$\vartheta_U = 45 ^\circ C$
U_{Rstoss}	siehe Tabelle V	$\vartheta_U = — ^\circ C$
I_{FAV}	3 A	$\vartheta_G = 100 ^\circ C$
I_{FSP}	25 A	$\vartheta_U = 45 ^\circ C$
I_{Fstoss}	100 A	$\vartheta_U = 45 ^\circ C, 100 ms, 50 Hz Halbwelle$
P	— W	$\vartheta_U = — ^\circ C$
ϑ_s	-55 bis +150 $^\circ C$	
ϑ_j	-55 bis +150 $^\circ C$	
ϑ_l	— $^\circ C$	$t_{\Sigma} = — s$
U_F	$\leq 1,5$ V	bei 3,14-fachem Nennstrom
I_R	$\leq 5 \mu A$	U_R - siehe Tabelle
I_N	2,5 A	mit Einheitskühlkörper
R_R	— Ω	
R_{thjG}	≤ 1 $grad/W$	
C_j	— pF	
C_G	— pF	
t_{rr}	— s	

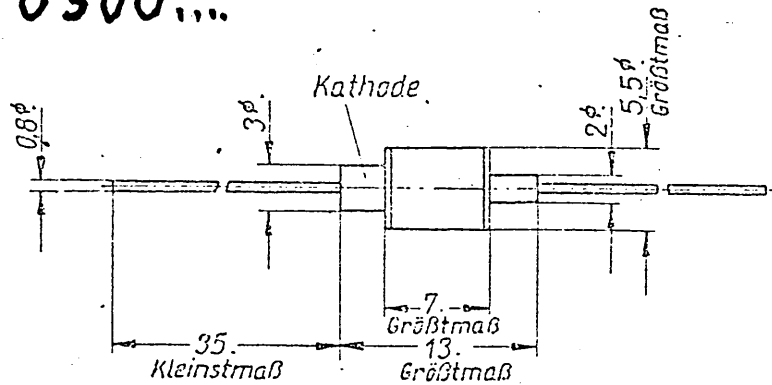
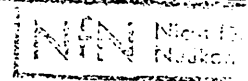
- 1.3. Kennwerte bei 25 $^\circ C$
 - 1.3.1. Durchlaßspannung:
 - 1.3.2. Sperrstrom:
 - 1.3.3. Nennstrom:
 - 1.3.4. Sperrwiderstand:
 - 1.3.5. Thermischer Widerstand:
 - 1.3.6. Sperrschicht-Kapazität:
 - 1.3.7. Gehäuse-Kapazität:
 - 1.3.8. Rückwärtserholzeit:

1.4. Obriige elektr. Werte nach Nortron Datenbuch 68/69 S.35

Silizium - Gleichrichter

600 mA

Nortron 0300...



Bayer

18. JUNI 1970

M 2:1

Kenndaten bei 25°C Umgebungstemperatur

Spitzen-Sperr-Spannung $V (U_{sp})$	Durchbruch-Spannung $V >$	Sperrstrom μA (bei U_{sp})	Spannungsabfall in Durchlassrichtung V	Höchstzul. Richtstrom mA	Typ
50	150	<1	<1,2	600	0300
200	400				0302
400	600				0304
700	900				0307

1 Eigenschaften:

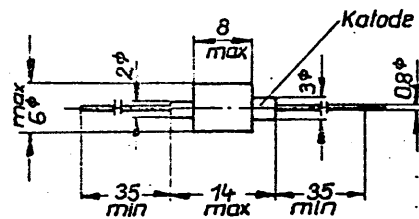
- Höchstzul. period. Spitzenstrom : 5 A
- Höchstzul. Stoßstrom : 30 A
- Verlustleistung : 1 W bei $\leq +50^\circ C$
- Höchste Kristalltemperatur : $+150^\circ C$
- Wärmewiderstand : $\chi < 100^\circ C/W$
- Temp. - Bereich : $-55^\circ C$ bis $+150^\circ C$
- Schaltung : Einwegschaltung

Leistungsgleichrichter Silizium

*Typ u. Kennzeichnung der Katode aufgestempelt

Eberle 0311

NFN Nicht für
Neukonstruktion



1. Eigenschaften:

1.1. Werkstoff: Gehäuse:

Keramik

1.2. Oberfläche:

1.3. Anschlüsse:

Lötbar verzinnt

1.4. Grenzwerte bei 25°C:

2.1. Sperrspannung:

$-U_d$ 100 V

2.2. Spitzen - Sperrspannung:

$-U_{dsp}$ 150 V

2.3. Stoßspannung:

$-U_{dstoß}$ 350 V

2.4. Richtstrom:

I_{richt} 0,6 A (ohne Kühlblech)

2.5. Durchlaß - Spitzenstrom:

I_{dsp} 5 A

2.6. Durchlaß - Stromstoß:

$I_{dstoß}$ 30 A (10 ms, 50 Hz Halbschwingung)

2.7. Verlustleistung:

P_d — W(t_{amb} — °C)

2.8. Sperrschichttemperatur:

ϑ_{jmax} — °C

ϑ_{jmin} — °C

2.9. Temperaturbereich:

ϑ_s -55 °C bis +150 °C

3. Elektrische Werte bei 25°C:

3.1. Durchlaßstrom:

I_d 2 A ($U_d = 14$ V)

3.2. Sperrstrom:

$-I_d$ 10 μ A ($-U_d = 100$ V)

$-I_d$ — A ($-U_d = —$ V)

3.3. Sperrwiderstand:

R_d — Ω ($-U_d = —$ V)

3.4. Thermischer Widerstand:

R_{therm} — °C/mW

3.5. Sperrschicht - Kapazität:

C_j — pF ($-U_d = —$ V, $f = —$ Hz)

3.6. Gehäuse - Kapazität:

C_{ak} — pF

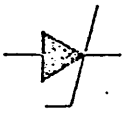
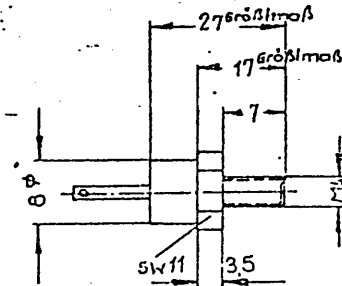
1.4. Übrige elektr. Werte nach:

ECO-Silizium-Halbleiter-Daten 1964, Seite 196

Zener-Diode Silizium

Nortron 1212

NIN Nicht für
Neukonstruk.



Gehäuse

JEDEC
DIN

1. Eigenschaften:

1.1. Werkstoff: (Gehäuse):

Metall

1.1.1. Oberfläche:

1.1.2. Anschlüsse:

lötbar verzinkt

1.2. Grenzwerte bei 25°C:

2.1. Durchbruchstrom:

2.2. Verlustleistung:

2.3. Sperrschichttemperatur:

2.4. Temperaturbereich (Lagerung):

Kennzgn.	Wert	Meßbedingung
I_Z	A	
P_{tot}	1,25 W	$\vartheta_u = 45^\circ C$
ϑ_j	+ 150 $^\circ C$	$\vartheta_g = \quad^\circ C$
ϑ_s	-55 bis +150 $^\circ C$	

1.3. Elektr.-Werte bei 25°C:

3.1. Durchbruchspannung:

3.2. Different. Durchbruchwiderst.:

3.3. Durchlaßspannung:

3.4. Sperrstrom:

3.5. Thermischer Widerstand

3.6. Temperaturkoeffizient der
Zenerspannung:

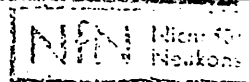
U_Z	10,7 bis 13,4 V	$I_Z = 300 \text{ mA}$
r_z	< 1 Ω	$I_Z = 300 \text{ mA}$
U_F	< 1,5 V	$I_F = 2 \text{ A}$
I_R	< 1 μA	$U_R = 7 \text{ V}$
R_{thU}	< 80 $^\circ C/W$	
R_{thG}	< 4 $^\circ C/W$	
TK_u	$\sim 8 \cdot 10^{-4} / ^\circ C$	$I_Z = 3 \text{ bis } 30 \text{ mA}$

1.4. Übrige elektr.-Werte nach:

Eberle Katalog 1964 S.29 ff

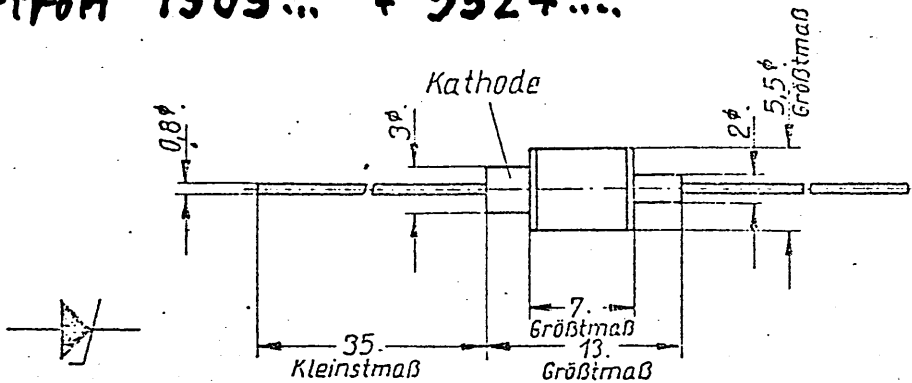
Silizium-Zenerdioden 1W Verlustleistung

Nortron 1305... + 5324...



Bayer

18. JUNI 1970



Kenndaten bei 25°C

M 2:1

$U_Z \pm 10\%$ bei J_Z		R_Z bei J_Z		$J_{sp} < 1\mu A$ bei Volt	J_Z Größtmaß mA	Typ
Volt	mA	Ω	mA			
5,6	100	3	100	1	160	1305
6,8	100	2	100	2	133	1306
8,2	100	2	100	3,5	110	1308
10	60	3	60	5	90	1310
12	60	4	50	7	75	1312
15	20	6	40	7	60	5324
18	20	10	40	9	50	5326
22	20	15	40	11	40	5328
27	20	30	30	13	34	5330
33	20	80	20	15	27	5332

1 Eigenschaften: Verlustleistung

$$Q = U_Z \cdot J_Z$$

$$Q = 1W \text{ bei } +50^\circ C$$

Wärmewiderstand

$$R \leq 100^\circ C/W$$

höchste Kristalltemperatur

$$+150^\circ C$$

Temp. - Bereich

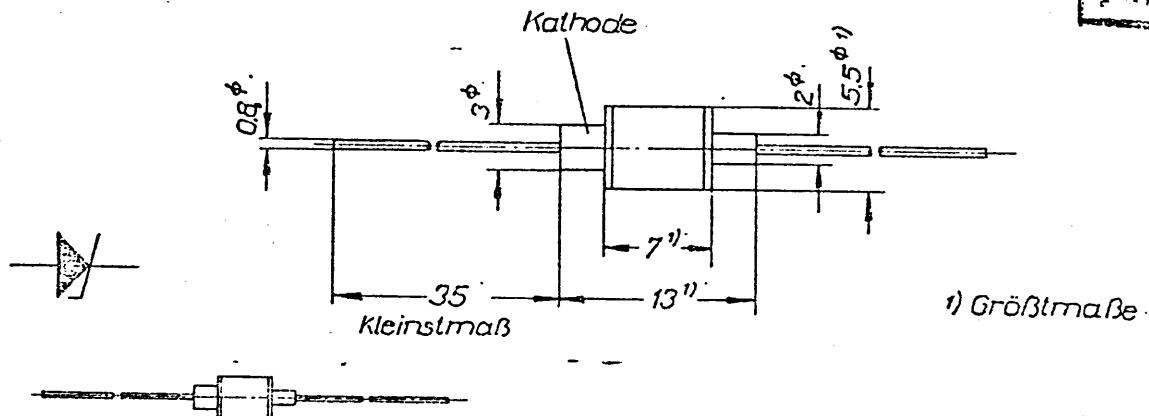
$$-55^\circ C \text{ bis } +150^\circ C$$

Spannungsabfall in Durch-
laßrichtung:

$$< 1,3 V \text{ bei } 500 mA$$

Nortran 1307c

NIN Noni for
Newcomers



Kennzahlen bei 25°C t_{umg} ^{M 1:1}

M 2:1

[illegible]

1 Eigenschaften:

Grenzdaten:

Verlustleistung

Größe Kristalltemperatur

Temperaturbereich

Größter Wärmewiderstand

X Durchlaßspannung

: 1W bei $t_{\text{umg}} \leq 50^\circ\text{C}$

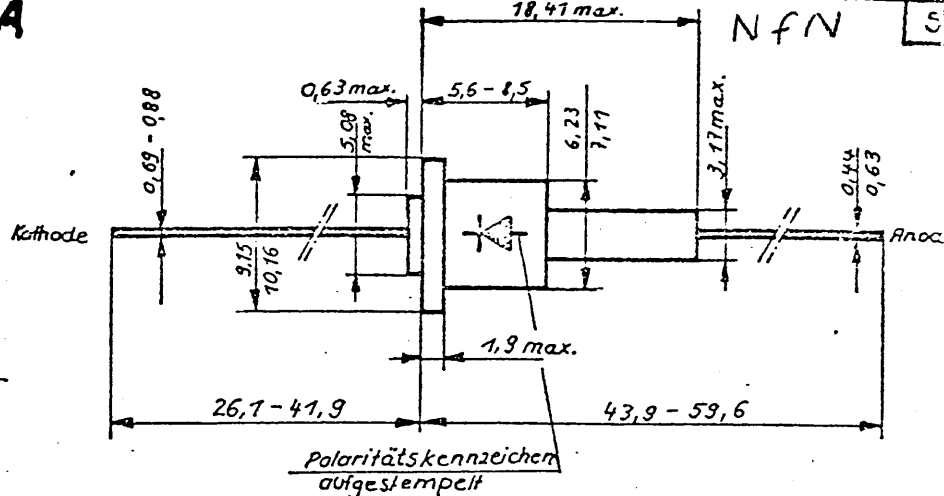
 $+150^{\circ}\text{C}$

: -55°C bis $+150^{\circ}\text{C}$.

 $: 100^{\circ}\text{C/W}$ (Kristall-Luft)

: 1,5V bei $t_{urng} = 25^\circ\text{C}$ u. $J_D = 500\text{ mA}$.

Sescosem 14 Z 6A



1. Eigenschaften

1.1. Mechanische Ausführung

1.1.1. Gehäuseart: JEDEC DO 3 / DIN -

1.1.2. Gehäusewerkstoff: Metall

1.1.3. Gehäuseoberfläche: —

1.1.4. Anschlußdrähte lötbar vzin/vgol

1.2. Grenzwerte

1.2.1. Durchbruchstrom:

1.2.2. Verlustleistung:

1.2.3. Temperaturbereich (Lagerung):

1.2.4. Sperrschichttemperatur:

1.2.5. Löttemperatur:

1.2.6. Thermischer Widerstand:

Formelzeichen	Wert	Meßbedingung
I_Z	— A	$\theta_u =$ — °C
P	1,0 W	$\theta_u =$ 25 °C
P	— W	$\theta_G =$ — °C
θ_s	-55 ... +150 °C	
θ_j	150 °C	
θ_l	245 °C	$t \leq 5 s$
R_{tlu}	125 °C/W	

1.3. Kennwerte bei 25 °C

Typ	U_Z ¹⁾	r_Z ¹⁾	I_Z max.	I_{ZS} ($t \leq 10 ms$)
14 Z 6A	4,3 V $\pm$ 6%	52 Ω	208 mA	1150 mA
15 Z 6A	4,7 V $\pm$ 6%	52 Ω	183 mA	1150 mA
23 Z 6A	10 V $\pm$ 6%	9 Ω	89 mA	600 mA
25 Z 6A	12 V $\pm$ 6%	12 Ω	75 mA	500 mA
27 Z 6A	8,2 V $\pm$ 6%	6 Ω	100 mA	750 mA

1) bei $I_Z = 10 mA$

1.4. Obribe elektr. Werte nach SESCO-Datenbuch 1967, S. 345 ff.

Transistor

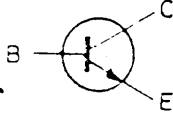
NPN - Si

Schrift gilt nur in Verbindung
mit Liefervorschrift N01-1451

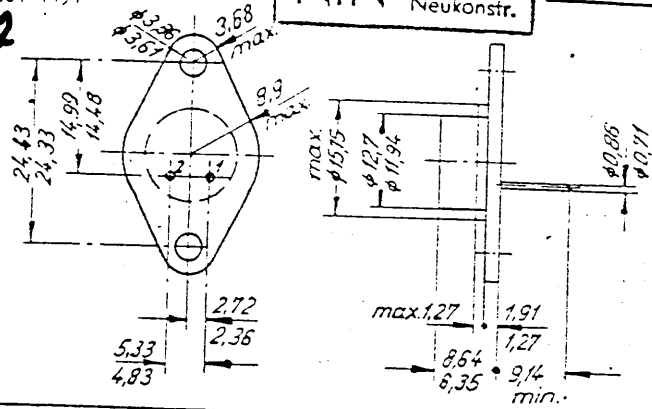
NfN Nicht für
Neukonstr.

54

1714-1402
kertron



Silicon
Transistor
Corp.



1. Eigenschaften
 - 1.1. Mechanische Ausführung
 - 1.1.1. Gehäuseart: JEDEC 10 - 66
 - 1.1.2. Gehäusewerkstoff: Metall
 - 1.1.3. Gehäuseoberfläche:
 - 1.1.4. Anschlußdrähte lotbar vzin/vgol

- 1.2. Grenzwerte
 - 1.2.1. Kollektor-Basis-Spannung:
 - 1.2.2. Kollektor-Emitter-Spannung:
 - 1.2.3. Emitter-Basis-Spannung:
 - 1.2.4. Kollektorstrom:
 - 1.2.5. Verlustleistung:
 - 1.2.6. Temperaturbereich (Lagerung):
 - 1.2.7. Sperrschicht-Temperatur:
 - 1.2.8. Löttemperatur:

- 1.3. Kennwerte bei 25°C
 - 1.3.1. Kollektor-Reststrom:
 - 1.3.2. Emitter-Reststrom:
 - 1.3.3. Grenzfrequenz:
 - 1.3.4. Gleichstrom-Verstärker-Faktor:
 - 1.3.5. Wechselstrom-Verstärker-Faktor:
 - 1.3.6. Kollektor-Sättigungsspannung:

- 1.3.7. Basis-Sättigungsspannung:
- 1.3.8. Ausgangs - Kapazität :
- 1.3.9. Emitter Sperrschicht-Kapazität.
- 1.3.10. Wärme-Innenwiderstand:
- 1.3.11. Wärmewiderstand:

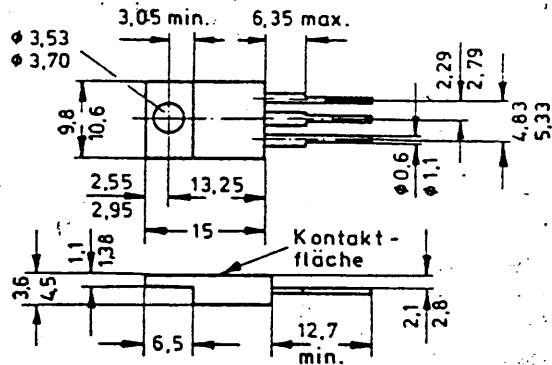
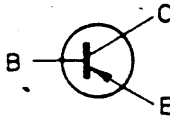
- 1.3.12. Einschaltzeit :
- 1.3.13. Speicherzeit :
- 1.3.14. Abfallzeit :

Formelzeichen	Wert	Meßbedingung
U_{CB0}	140 V	$\vartheta_u =$ °C
U_{CE0}	140 V	$\vartheta_u =$ °C
U_{EB0}	7 V	$\vartheta_u =$ °C
I_C	10 A	$\vartheta_u =$ °C
P_{tot}	20 W	$\vartheta_G = 100$ °C
ϑ_s	-65...+200 °C	
ϑ_i	-65...+200 °C	
ϑ_l	245 °C	$t \leq 5$ s
I_{CEX}	$\leq 2,5$ mA	$U_{CE} = 140$ V, $U_{EB} = 1,5$ V
I_{CEX}	$\leq 5,0$ mA	$U_{CE} = 140$ V, $\vartheta_G = 150$ °C, $U_{EB} = 1,5$ V
I_{EB0}	$\leq 0,5$ µA	$U_{EB} = 5$ V, $I_C = 0$
f_T	≤ 40 MHz	$U_{CE} = 10$ V, $I_C = 1,0$ A, $f = 10$ MHz
B	≤ 20	$U_{CE} = 2,0$ V, $I_C = 2$ A
h_{fe}	—	$U_{CE} =$ V, $I_C =$ A, $f =$ KHz
U_{CEsat}	$\leq 0,60$ V	$I_C = 2$ A, $I_B = 160$ mA
U_{CEsat}	$\leq$ V	$I_C =$ A, $I_B =$ A
U_{EBsat}	$\leq 1,25$ V	$I_C = 2$ A, $I_B = 160$ mA
C_{ob}	≤ 250 pF	$U_{CB} = 10$ V, $I_E = 0$ A, $f = 1,0$ MHz
C_{ES}	$\leq$ pF	$U_{EB} =$ V, $I_C =$ A, $f =$ MHz
R_{thG}	$\leq 5,0$ °C/W	—
R_{thU}	— °C/mW	—
t_{on}	≤ 300 ns	$I_{Bon} = I_{Botf} = 160$ mA, $I_C = 2$ A;
t_s	≤ 600 ns	$U_{CC} = 30$ V
t_f	≤ 300 ns	

RCA 18366 Transistor

PNP - Silizium

= 2N6187 selektiert



1. **Eigenschaften**
- 1.1. **Mechanische Ausführung**
- 1.1.1. Gehäuseart: JEDEC TO-220 AB
- 1.1.2. Gehäusewerkstoff: Kunststoff
- 1.1.3. Gehäuseoberfläche: -
- 1.1.4. Anschlußdrähte lötbar vzin/vgol

1.2. Grenzwerte

- 1.2.1. Kollektor-Basis-Spannung:
- 1.2.2. Kollektor-Emitter-Spannung:
- 1.2.3. Emitter-Basis-Spannung:
- 1.2.4. Kollektorstrom:
- 1.2.5. Verlustleistung:
- 1.2.6. Temperaturbereich (Lagerung):
- 1.2.7. Sperrschicht-Temperatur:
- 1.2.8. Löttemperatur:

1.3. Kennwerte bei 25° C

1.3.1. Kollektor-Reststrom:

1.3.2. Emitter-Reststrom:

1.3.3. Grenzfrequenz:

1.3.4. Gleichstrom-Verstärker-Faktor:

1.3.5. Wechselstrom-Verstärker-Faktor:

1.3.6. Kollektor-Sättigungsspannung:

1.3.7. Basis-Emitterspannung:

1.3.8. Kollektor-Sperrschicht-Kapazität:

1.3.9. Emitter-Sperrschicht-Kapazität:

1.3.10. Wärme-Innenwiderstand:

1.3.11. Wärmewiderstand:

1.3.12. Schaltzeiten:

Formelzeichen	Wert	Meßbedingung
U_{CBO}	- 80 V	$\theta_u = 25^\circ \text{C}$
U_{CEO}	- 70 V	$\theta_u = 25^\circ \text{C}$
U_{EBO}	- 7 V	$\theta_u = 25^\circ \text{C}$
I_C	- 4 A	$\theta_u = 25^\circ \text{C}$
P_{tot}	36 W	$\theta_G = 25^\circ \text{C}$
θ_s	-65...+150 °C	
θ_i	- °C	
θ_l	245 °C	$t \leq 5 \text{ s}$
I_{CER}	$\leq -0,5 \text{ mA}$	$U_{CE} = -50 \text{ V}, R_{BE} = 100 \Omega$
I_{CER}	$\leq -2,0 \text{ mA}$	$U_{CE} = -50 \text{ V}, R_{BE} = 100 \Omega, \theta_G = 150^\circ \text{C}$
I_{EBO}	$\leq -1,0 \text{ mA}$	$U_{EB} = -5 \text{ V}$
f_T	$\approx 0,8 \text{ MHz}$	$U_{CE} = -4 \text{ V}, I_C = -0,2 \text{ A}, f = 0,1 \text{ MHz}$
B	30... 225	$U_{CE} = -4 \text{ V}, I_C = -0,5 \text{ A}$
h_{fe}	-	$U_{CE} = -4 \text{ V}, I_C = -0,5 \text{ A}, f = 1 \text{ KHz}$
U_{CEsat}	$\leq -1,0 \text{ V}$	$I_C = -2,0 \text{ A}, I_B = -0,2 \text{ A}$
U_{CEsat}^*	$\leq -0,5 \text{ V}$	$I_C = -0,5 \text{ A}, I_B = -25 \text{ mA}$
U_{BE}	$\leq -1,1 \text{ V}$	$I_C = -0,5 \text{ A}, U_{CE} = -4 \text{ V}$
C_{CS}	- pF	$U_{CB} = -50 \text{ V}, I_E = -0,5 \text{ A}, f = 1 \text{ MHz}$
C_{ES}	- pF	$U_{EB} = -50 \text{ V}, I_C = -0,5 \text{ A}, f = 1 \text{ MHz}$
R_{thG}	$\leq 3,5^\circ \text{C/W}$	
R_{thU}	$\leq 70^\circ \text{C/W}$	
t_{on}	$\leq 5,0 \mu\text{s}$	$U_{CE} = -30 \text{ V}, I_C = -0,5 \text{ A}, I_B = -50 \text{ mA}$
t_{off}	$\leq 15,0 \mu\text{s}$	

* Diese Werte sind gegenüber dem Datenblatt eingeengt

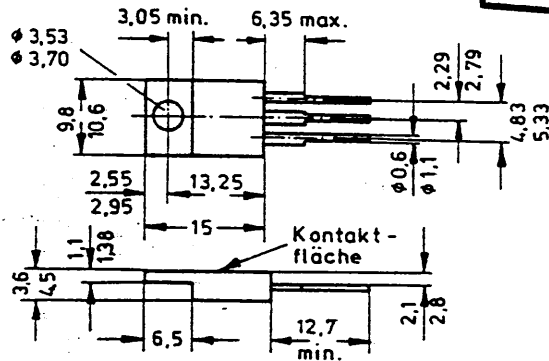
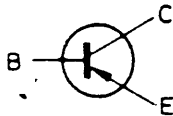
RCA 18367 Transistor

PNP - Silizium

= 2N6491 selektiert

NfN

Nicht für
Neukonstr.



1. Eigenschaften

- 1.1. Mechanische Ausführung
 - 1.1.1. Gehäuseart: JEDEC TO-220 AB
 - 1.1.2. Gehäusewerkstoff: Kunststoff
 - 1.1.3. Gehäuseoberfläche: -
 - 1.1.4. Anschlußdrähte lötlbar vzin/vgol

1.2. Grenzwerte

- 1.2.1. Kollektor-Basis-Spannung:
- 1.2.2. Kollektor-Emitter-Spannung:
- 1.2.3. Emitter-Basis-Spannung:
- 1.2.4. Kollektorstrom:
- 1.2.5. Verlustleistung:
- 1.2.6. Temperaturbereich (Lagerung):
- 1.2.7. Sperrschicht-Temperatur:
- 1.2.8. Löttemperatur:

Formelzeichen	Wert	Meßbedingung
U_{CBO}	-90 V	$\theta_u = 25^\circ\text{C}$
U_{CEO}	-80 V	$\theta_u = 25^\circ\text{C}$
U_{EBO}	-5 V	$\theta_u = 25^\circ\text{C}$
I_C	-15 A	$\theta_u = 25^\circ\text{C}$
P_{tot}	75 W	$\theta_G = 25^\circ\text{C}$
θ_s	-65...+150 $^\circ\text{C}$	
θ_i	+150 $^\circ\text{C}$	
θ_l	245 $^\circ\text{C}$	$t \leq 5 \text{ s}$
1.3. Kennwerte bei 25° C		
1.3.1. Kollektor-Reststrom:	$I_{CEO} \leq -1 \text{ A}$	$U_{CE} = -40 \text{ V}$
	$I_{CBO} \leq - \text{ A}$	$U_{CB} = \text{ V, } \theta_u = \text{ }^\circ\text{C}$
1.3.2. Emitter-Reststrom:	$I_{EBO} \leq 1,0 \text{ A}$	$U_{EB} = -5 \text{ V}$
1.3.3. Wechselstrom-Verstärker-Faktor:	$\beta \geq 25$	$U_{CE} = -4 \text{ V, } I_C = -1 \text{ A, } f = 0,1 \text{ MHz}$
1.3.4. Gleichstrom-Verstärker-Faktor:	$B \geq 20...150$	$U_{CE} = -4 \text{ V, } I_C = -5 \text{ A}$
1.3.5. Gleichstrom-Verstärker-Faktor:	$\beta \geq 5,0$	$U_{CE} = -4 \text{ V, } I_C = 15 \text{ A, } f = \text{ KHz}$
1.3.6. Kollektor-Sättigungsspannung:	$U_{CEsat} \leq -3,5 \text{ V}$	$I_C = -15 \text{ A, } I_B = -5 \text{ A}$
	$U_{CEsat 1) \leq -0,5 \text{ V}$	$I_C = -4 \text{ A, } I_B = -0,2 \text{ A}$
1.3.7. Basis-Emitterspannung:	$U_{BE} \leq -1,3 \text{ V}$	$I_C = -5 \text{ A, } U_{CE} = -4 \text{ V}$
1.3.8. Kollektor-Sperrschicht-Kapazität:	$C_{CS} \text{ - pF}$	$U_{CB} = \text{ V, } I_E = \text{ A, } f = \text{ MHz}$
1.3.9. Emitter-Sperrschicht-Kapazität:	$C_{ES} \text{ - pF}$	$U_{EB} = \text{ V, } I_C = \text{ A, } f = \text{ MHz}$
1.3.10. Wärme-Innenwiderstand:	$R_{thG} \leq 1,67 \text{ }^\circ\text{K/W}$	
1.3.11. Wärmewiderstand:	$R_{thU} \leq 70 \text{ }^\circ\text{K/W}$	

1) Diese Werte sind gegenüber dem Datenblatt eingeschränkt

1.4. Übrige elektr. Werte nach RCA-Daten 1981